

2SC154(H)

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

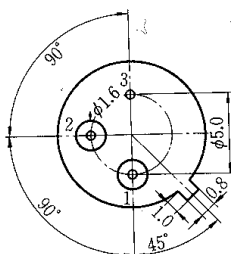
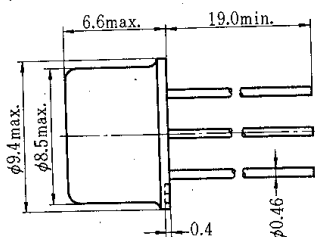
高周波増幅用

高電圧中速度スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP

HIGH FREQUENCY AMPLIFIER

HIGH VOLTAGE MEDIUM SPEED SWITCHING



1. エミッタ: Emitter
2. ベース: Base
3. コレクタ: Collector
- (ケース) (Case)

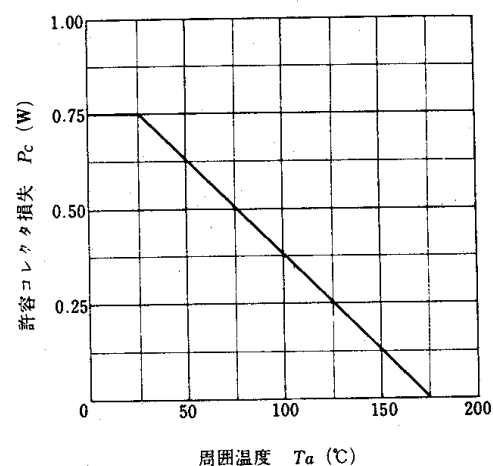
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-39)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC154(H)	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CB0}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	70	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EB0}	5	V
コレクタ電流		I_C	100	mA
エミッタ電流		I_E	-100	mA
許容コレクタ損失		P_C	750	mW
接合部温度		T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBX}$	$I_C=10\mu\text{A}$, $V_{EB}=0.5\text{V}$	120	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.5\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	70	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\mu\text{A}$, $I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}$, $I_E=0$	—	0.08	100	nA
直流電流増幅率		h_{FE}^*	$V_{CE}=6\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$	35	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=3\text{mA}$	—	—	0.5	V
高周波電流増幅率		h_{fe}	$V_{CE}=6\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=20\text{MHz}$	4.0	—	—	
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$	—	—	8	pF
入力インピーダンス抵抗分		$h_{ie}(\text{real})$	$V_{CE}=6\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=150\text{MHz}$	—	—	120	Ω
小信号入力インピーダンス		h_{ie}	$V_{CE}=6\text{V}$, $I_E=-1\text{mA}$, $f=1\text{kHz}$	—	2	—	k Ω
小信号電圧帰還率		h_{re}		—	4	—	$\times 10^{-5}$
小信号電流増幅率		h_{fe}		—	80	—	
小信号出力アドミタンス		h_{oe}		—	10	—	μS

* 2SC154(H) は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

* The 2SC154(H) is grouped by h_{FE} as follows.

A	B	C
35~70	60~120	100~200